

低リップル 800mA LDOレギュレータ

NO.JA-088-120417

■ 概要

R1170xシリーズはCMOSプロセス技術を用いて開発した、低入力電圧差、高精度、低消費電流の正電圧ボルテージレギュレータICで、基準電圧源、誤差増幅器、出力電圧設定用抵抗網、短絡電流制限回路、チップイネーブル回路、サーマルシャットダウン回路等から構成されています。

出力電圧はIC内で固定されています。

CMOSプロセスによる低消費電流特性に加え、低ON抵抗 T_r 内蔵による低入出力電圧差及びチップイネーブル機能により電池の高寿命化に対応できます。また、従来のCMOSプロセスによるレギュレータに比べ、出力電流、リップル除去率、入力過渡応答、負荷過渡応答特性に優れ、携帯機器の電源に適した製品となっております。

パッケージは、SOT-89-5、HSOP-6Jに実装することにより、高密度実装を狙ったものとワットテージの高いHSOP-6Jに実装したものをご用意しております。

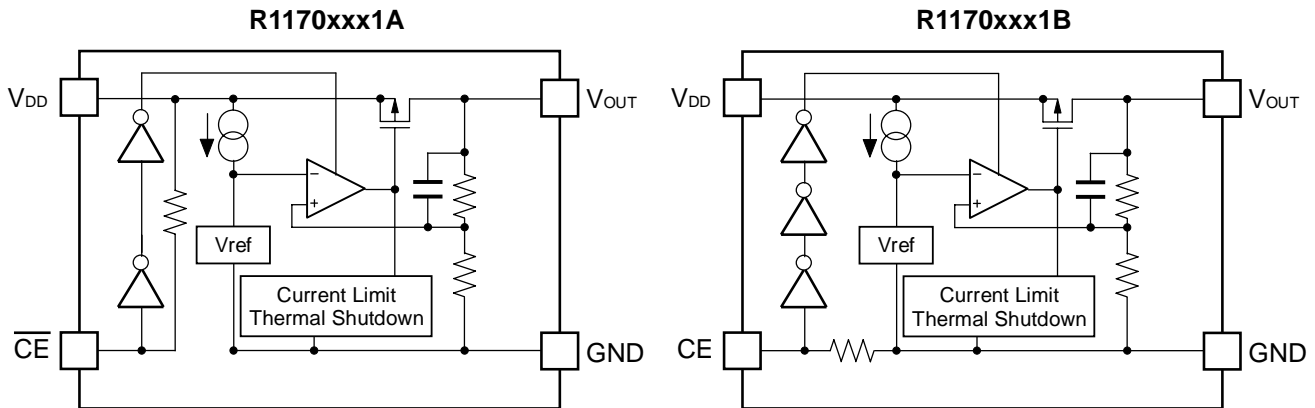
■ 特長

- 消費電流 TYP. 80 μ A
- 消費電流(スタンバイ時) TYP. 0.1 μ A
- 出力電流 MIN. 800mA ($V_{IN}=V_{OUT}+1.0V$)
- 入出力電圧差 TYP. 0.12V ($V_{OUT}=3.0V, I_{OUT}=300mA$)
- 出力電圧精度 $\pm 2.0\%$
- 出力電圧の温度係数 TYP. $\pm 100ppm/^{\circ}C$
- 入力安定度 TYP. 0.05%/V
- 出力電圧範囲 1.5V~5.0V (0.1V単位)
*その他の電圧はマーキング情報をご参照ください。
- 短絡電流制限回路内蔵
- 過電流保護回路内蔵
- サーマルシャットダウン回路内蔵
- パッケージ HSOP-6、SOT-89-5、HSOP-6J
- セラミックコンデンサ対応

■ アプリケーション

- ノートPC用定電圧源
- 携帯用通信機器、カメラ、ビデオの定電圧源
- バッテリー使用機器の定電圧源
- 家庭用電気製品の定電圧源

ブロック図



■ セレクションガイド

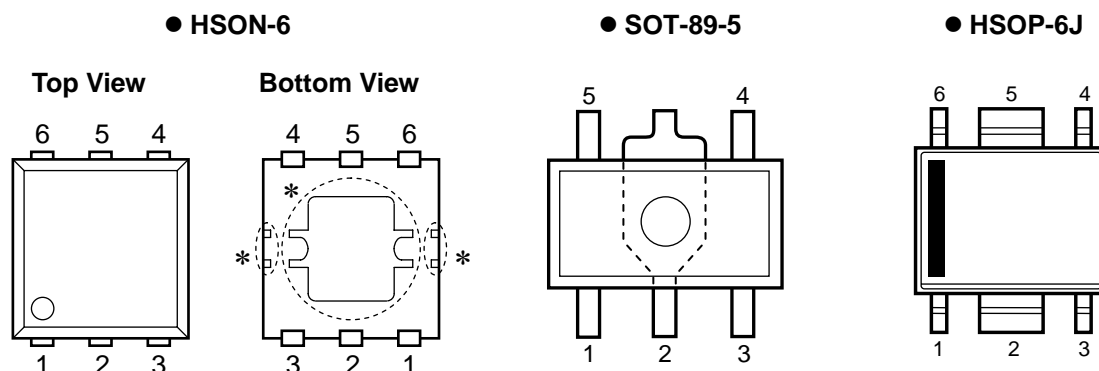
R1170xシリーズは、出力電圧、CE端子の極性、パッケージを用途によって選択指定することができます。

製品名	パッケージ	1 リール個数	鉛フリー	ハロゲンフリー
R1170Dxx1*-TR-FE	HSOP-6	3,000pcs	○	○
R1170Hxx1*-T1-FE	SOT-89-5	1,000pcs	○	○
R1170Sxx1*-E2-FE	HSOP-6J	1,000pcs	○	○

xx : 出力電圧を 1.5V (50) ~5.0V (50) まで、0.1V 単位で指定
(その他の電圧はマーキング情報をご参照ください。)

* : CE 端子の極性を下記から選択
(A) "L"アクティブ
(B) "H"アクティブ

■ 端子接続図



■ 端子説明

● HSON-6

端子番号	端子名	機能
1	V_{OUT}^{*1}	VR 出力端子
2	V_{OUT}^{*1}	VR 出力端子
3	\overline{CE} または CE	チップイネーブル端子
4	GND	グラウンド端子
5	V_{DD}^{*1}	入力端子
6	V_{DD}^{*1}	入力端子

*) 丸く囲んでいる点線部分にあるタブ、および、タブ吊りリードは基板電位 (GND) です。タブはGND端子と接続する (推奨) か、オープンとしてください。タブ吊りリードは基板設計の際に他の配線とショートしないようご注意ください。

*1) 基板実装時には、 V_{OUT} ピン、 V_{DD} ピン同士を必ず接続してください。

● SOT-89-5

端子番号	端子名	機能
1	\overline{CE} または CE	チップイネーブル端子
2	GND	グラウンド端子
3	NC	ノーコネクション
4	V_{DD}	入力端子
5	V_{OUT}	VR 出力端子

● HSOP-6J

端子番号	端子名	機能
1	V _{OUT}	VR 出力端子
2	GND ^{*1}	グラウンド端子
3	$\overline{\text{CE}}$ または CE	チップイネーブル端子
4	NC	ノーコネクション
5	GND ^{*1}	グラウンド端子
6	V _{DD}	入力端子

*1) 基板実装時には、GNDピン同士を必ず接続してください。

■ 絶対最大定格

記号	項目	定格	単位
V _{IN}	入力電圧	7.0	V
V _{CE}	入力電圧 ($\overline{\text{CE}}$ または CE 端子)	-0.3~V _{IN} +0.3	V
V _{OUT}	出力電圧	-0.3~V _{IN} +0.3	V
P _D	許容損失 (HSOP-6) (標準実装条件)*	900	mW
	許容損失 (SOT-89-5) (標準実装条件)*	900	
	許容損失 (HSOP-6J) (標準実装条件)*	1700	
T _{opt}	動作周囲温度	-40~85	°C
T _{stg}	保存周囲温度	-55~125	°C

*) 許容損失、標準実装条件については、パッケージ情報に詳しく記述していますのでご参照ください。

絶対最大定格

絶対最大定格に記載された値を超えた条件下に置くことはデバイスに永久的な破壊をもたらすことがあるばかりか、デバイス及びそれを使用している機器の信頼性及び安全性に悪影響をもたらします。絶対最大定格値でデバイスが機能動作をすることは保証していません。

■ 電気的特性

R1170xxxxA

T_{opt}=25°C

記号	項目	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位	
V _{IN}	入力電圧				6.0	V	
I _{SS}	消費電流	V _{IN} -V _{OUT} =1.0V, V _{CE} =0V		80	160	μA	
I _{standby}	消費電流(スタンバイ時)	V _{IN} =V _{CE} =6.0V		0.1	1.0	μA	
V _{OUT}	出力電圧	V _{IN} -V _{OUT} =1.0V, I _{OUT} =100mA	× 0.98		× 1.02	V	
ΔV _{OUT} /ΔI _{OUT}	負荷安定度	V _{IN} -V _{OUT} =1.0V 1mA ≤ I _{OUT} ≤ 300mA		30	100	mV	
V _{DIF}	入出力電圧差	I _{OUT} =300mA	V _{OUT} =1.5V		0.35	0.45	V
			V _{OUT} =1.6V		0.30	0.35	
			V _{OUT} =1.7V		0.25	0.30	
			1.8V ≤ V _{OUT} ≤ 2.0V		0.20	0.25	
			2.1V ≤ V _{OUT} ≤ 2.4V		0.15	0.20	
			2.5V ≤ V _{OUT} ≤ 5.0V		0.12	0.18	
ΔV _{OUT} /ΔV _{IN}	入力安定度	I _{OUT} =100mA V _{OUT} +0.5V ≤ V _{IN} ≤ 6.0V		0.05	0.30	%/V	
RR	リップル除去率	1.5V ≤ V _{OUT} ≤ 4.7V : f=1kHz, V _{IN} -V _{OUT} =1.0V, リップル 0.5Vp-p		50		dB	
		4.8V ≤ V _{OUT} ≤ 5.0V : f=1kHz, V _{IN} =5.7V, リップル 0.5Vp-p		50			
ΔV _{OUT} /ΔT _{opt}	出力電圧温度係数	I _{OUT} =10mA, V _{IN} -V _{OUT} =1.0V -40°C ≤ T _{opt} ≤ 85°C		±100		ppm/°C	
I _{LIM}	出力電流制限	V _{IN} -V _{OUT} =1.0V	800			mA	
I _{SC}	短絡電流	V _{OUT} =0V		40		mA	
R _{PU}	CE プルアップ抵抗		1.25	2.50	5.00	MΩ	
V _{CEH}	CE 入力電圧"H"		1.5		V _{IN}	V	
V _{CEL}	CE 入力電圧"L"		0		0.25	V	
T _{TSD}	サーマルシャットダウン 検出温度	ジャンクション温度		150		°C	
T _{TSR}	サーマルシャットダウン 解除温度	ジャンクション温度		120		°C	

動作定格 (電気的特性) について

半導体が使用される応用電子機器は半導体がその動作定格範囲で動作するように設計する必要があります。ノイズ、サージといえどもその範囲を超えると半導体の正常な動作は期待できなくなります。また動作定格の範囲外で動作させ続けた場合は、その半導体が本来持っている信頼性を維持できなくなります。

R1170x

R1170xxxxB

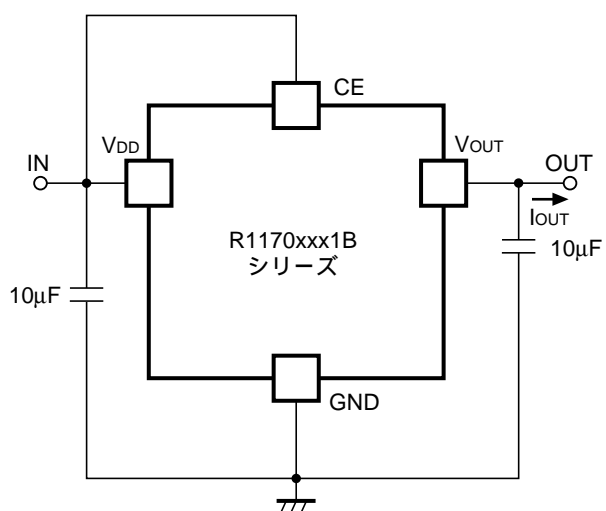
T_{opt}=25°C

記号	項目	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位	
V _{IN}	入力電圧				6.0	V	
I _{SS}	消費電流	V _{IN} -V _{OUT} =1.0V, V _{IN} =V _{CE}		80	160	μA	
I _{standby}	消費電流(スタンバイ時)	V _{IN} =6.0V, V _{CE} =0V		0.1	1.0	μA	
V _{OUT}	出力電圧	V _{IN} -V _{OUT} =1.0V, I _{OUT} =100mA	× 0.98		× 1.02	V	
ΔV _{OUT} /ΔI _{OUT}	負荷安定度	V _{IN} -V _{OUT} =1.0V 1mA ≤ I _{OUT} ≤ 300mA		30	100	mV	
V _{DIF}	入出力電圧差	I _{OUT} =300mA	V _{OUT} =1.5V		0.35	0.45	V
			V _{OUT} =1.6V		0.30	0.35	
			V _{OUT} =1.7V		0.25	0.30	
			1.8V ≤ V _{OUT} ≤ 2.0V		0.20	0.25	
			2.1V ≤ V _{OUT} ≤ 2.4V		0.15	0.20	
			2.5V ≤ V _{OUT} ≤ 5.0V		0.12	0.18	
ΔV _{OUT} /ΔV _{IN}	入力安定度	I _{OUT} =100mA V _{OUT} +0.5V ≤ V _{IN} ≤ 6.0V		0.05	0.30	%/V	
RR	リップル除去率	1.5V ≤ V _{OUT} ≤ 4.7V : f=1kHz, V _{IN} -V _{OUT} =1.0V, リップル 0.5Vp-p		50		dB	
		4.8V ≤ V _{OUT} ≤ 5.0V : f=1kHz, V _{IN} =5.7V, リップル 0.5Vp-p		50			
ΔV _{OUT} /ΔT _{opt}	出力電圧温度係数	I _{OUT} =10mA, V _{IN} -V _{OUT} =1.0V -40°C ≤ T _{opt} ≤ 85°C		±100		ppm/°C	
I _{LIM}	出力電流制限	V _{IN} -V _{OUT} =1.0V	800			mA	
I _{SC}	短絡電流	V _{OUT} =0V		40		mA	
R _{PD}	CE プルダウン抵抗		1.25	2.50	5.00	MΩ	
V _{CEH}	CE 入力電圧"H"		1.5		V _{IN}	V	
V _{CEL}	CE 入力電圧"L"		0		0.25	V	
T _{TSD}	サーマルシャットダウン 検出温度	ジャンクション温度		150		°C	
T _{TSR}	サーマルシャットダウン 解除温度	ジャンクション温度		120		°C	

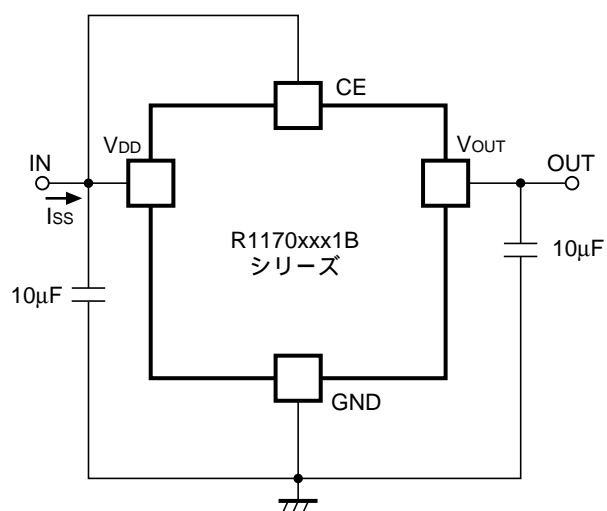
動作定格（電気的特性）について

半導体が使用される応用電子機器は半導体がその動作定格範囲で動作するように設計する必要があります。ノイズ、サージといえどもその範囲を超えると半導体の正常な動作は期待できなくなります。また動作定格の範囲外で動作させ続けた場合は、その半導体が本来持っている信頼性を維持できなくなります。

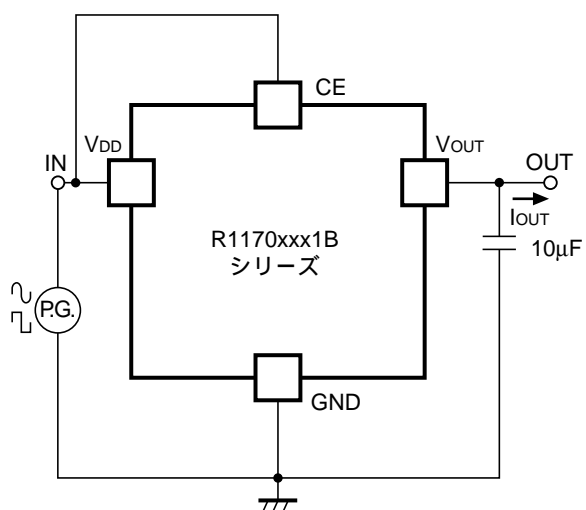
■ 測定回路



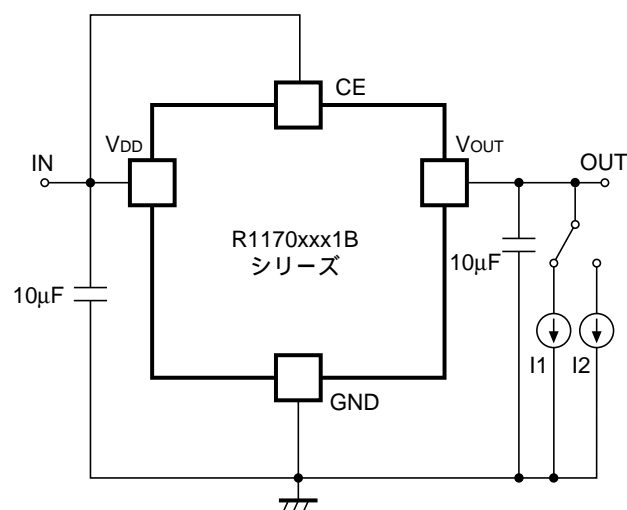
基本測定回路



消費電流測定回路



リップル除去率、入力過渡応答特性測定回路



負荷過渡応答測定回路

■ 外付け回路例と使用上の注意点

位相補償について

本 IC は、出力負荷が変化しても安定に動作させるために、出力段にて位相補償を行っています。

このためコンデンサ CL として $10\mu\text{F}$ 程度を必ず入れて下さい。

なお、タンタルコンデンサ等を使用する場合、直列等価抵抗 (ESR) の値が大きいと出力が発振する可能性がありますので周波数特性を含めて充分評価して下さい。

応答時間について

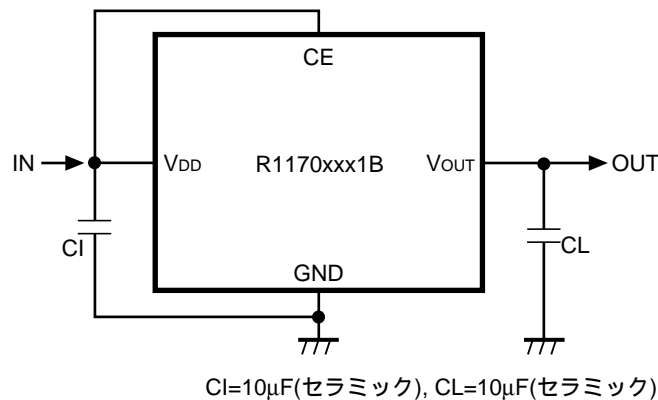
CE による応答時間は、コンデンサの容量が大きいほどばらつきも大きくなります。

$40\mu\text{F}$ 以上の出力コンデンサをつけると、オフ時間の長さによっても変動することがあります。

基板実装について

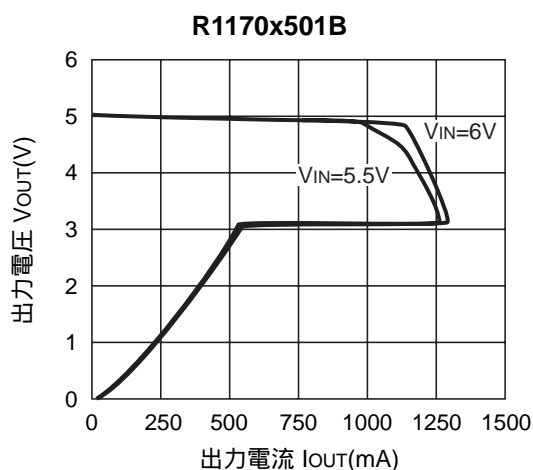
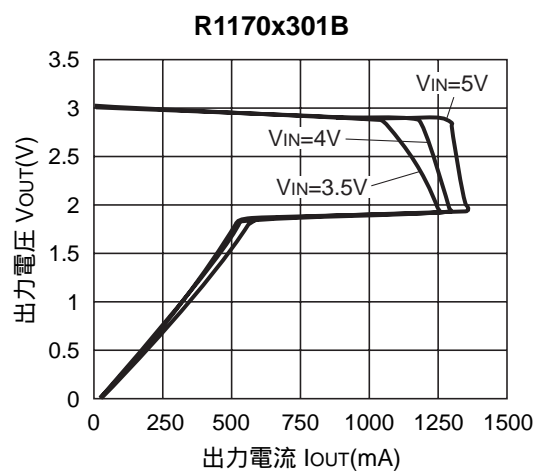
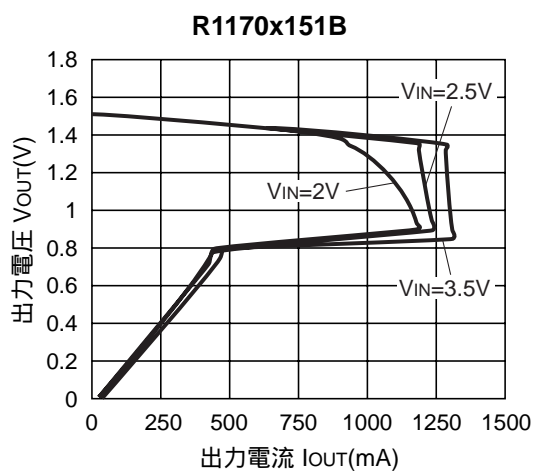
V_{DD} および GND 配線は、電流が流れるため配線のインピーダンスが高いとノイズのまわり込みや動作が不安定になる原因になるので充分強化して下さい。また、 V_{DD} 端子-GND 端子間に $10\mu\text{F}$ 程度の容量をできるだけ配線が短くなるように付けて下さい。

さらに、位相補償用の出力側コンデンサについては V_{OUT} 端子と GND 間にできるだけ配線が短くなるように付けて下さい。(基本回路例参照)

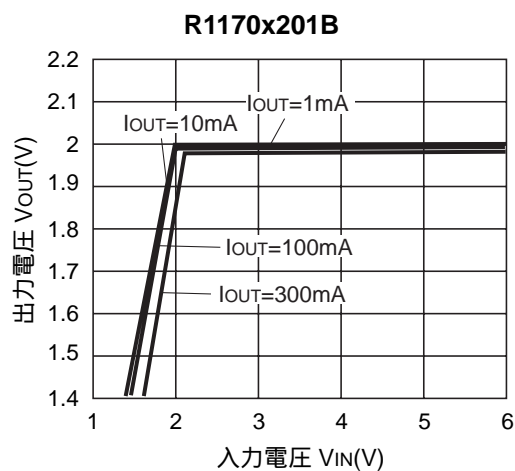
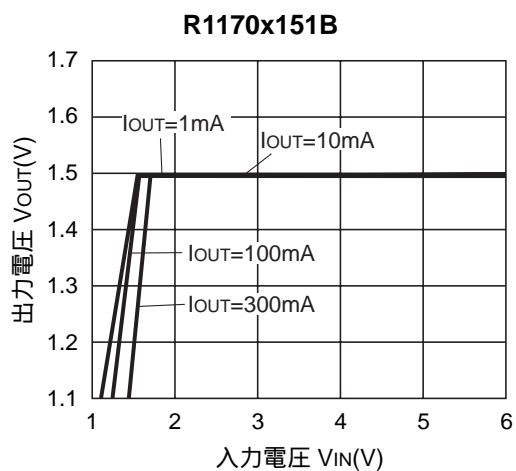


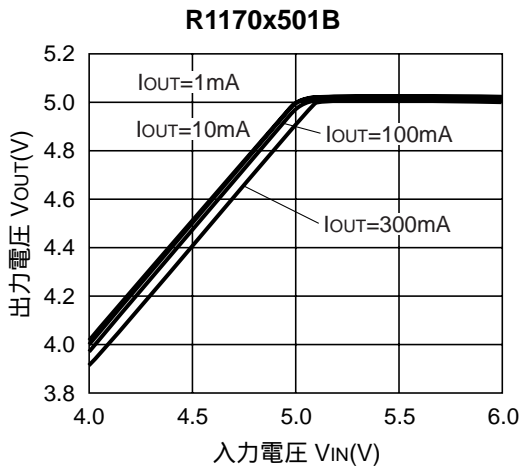
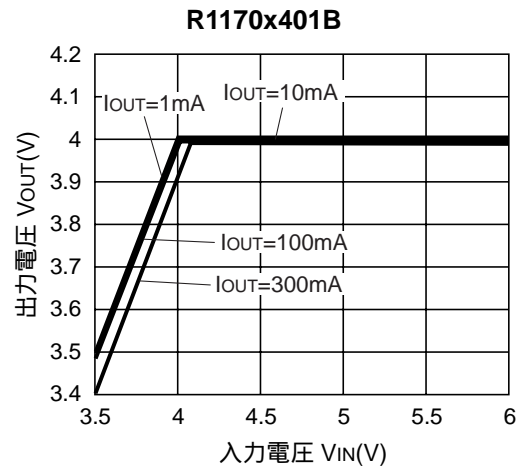
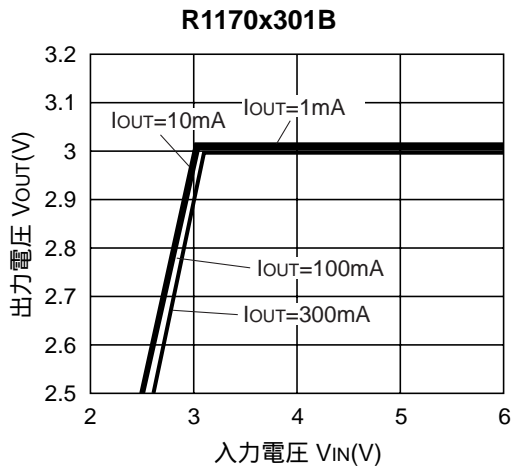
■ 特性例

1) 出力電圧対出力電流特性例 (T_{opt}=25°C)

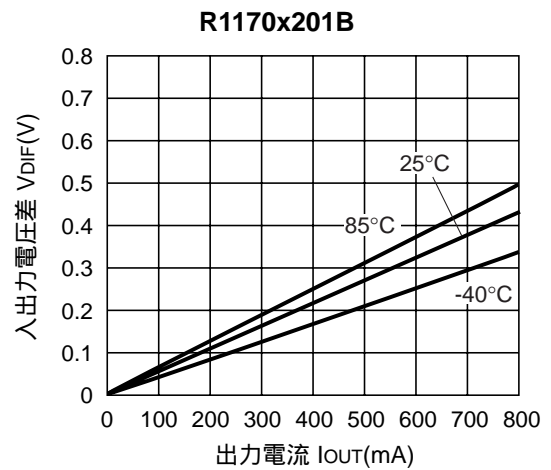
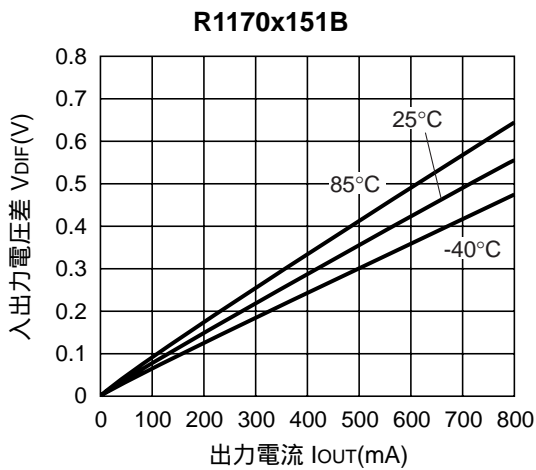


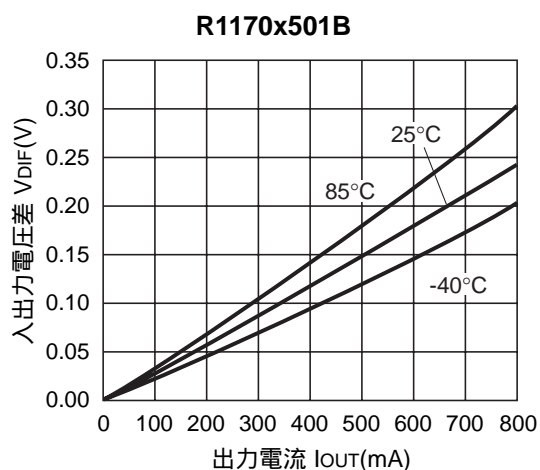
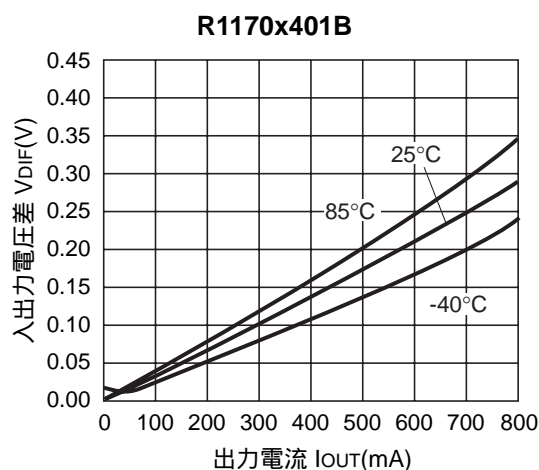
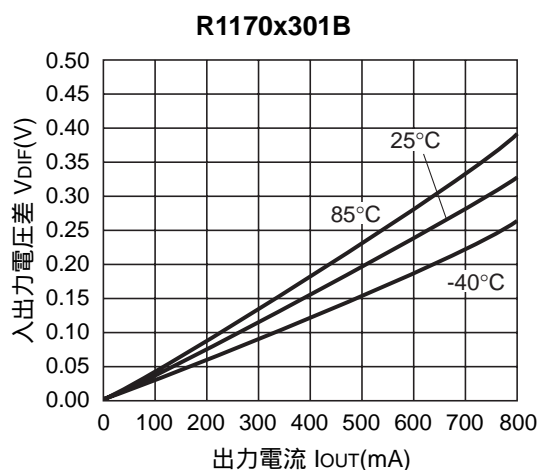
2) 出力電圧対入力電圧特性例(T_{opt}=25°C)



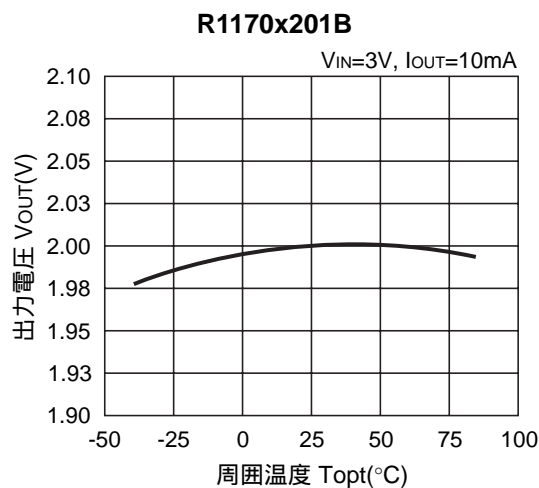
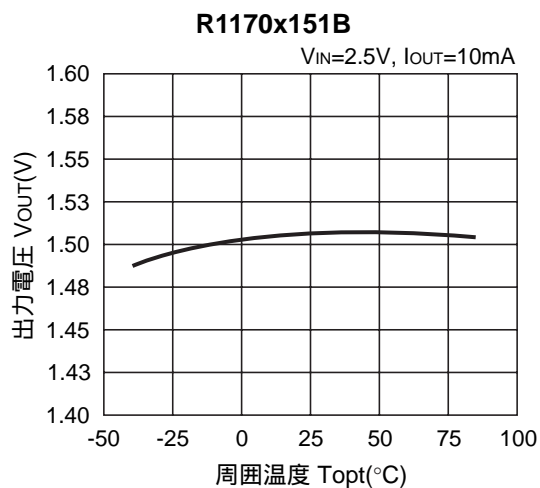


3) 入出力電圧差対出力電流特性例

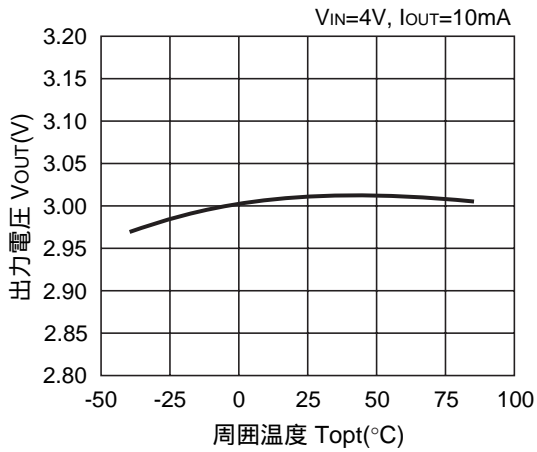




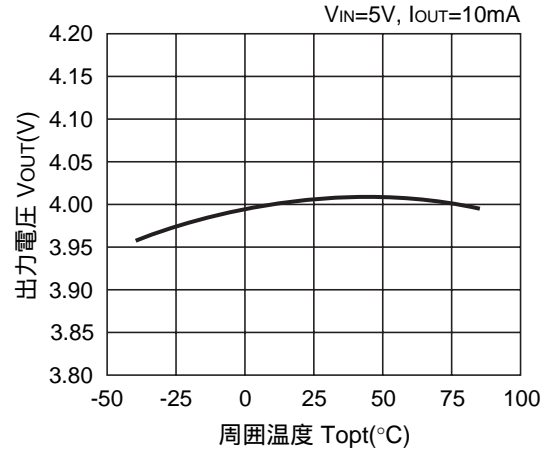
4) 出力電圧対周囲温度特性例



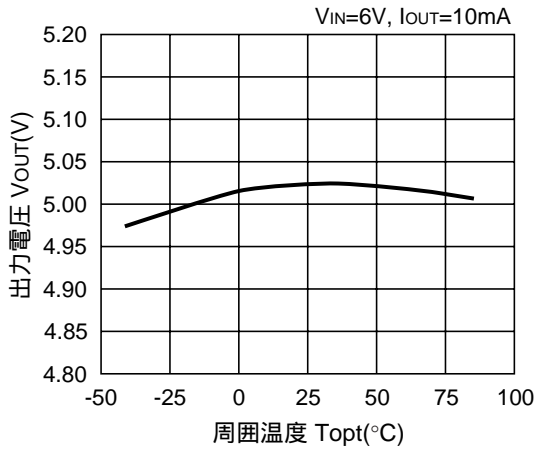
R1170x301B



R1170x401B

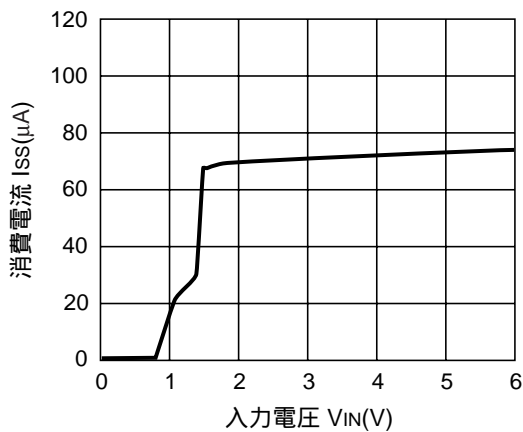


R1170x501B

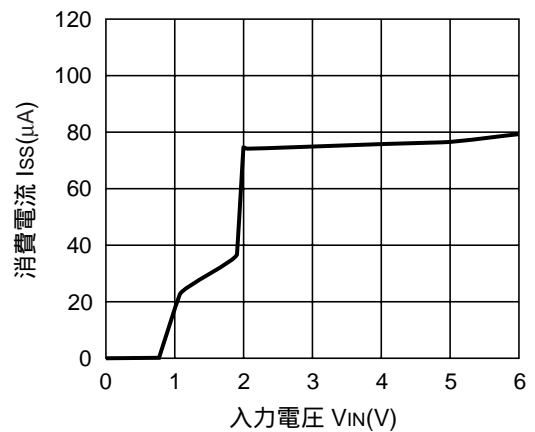


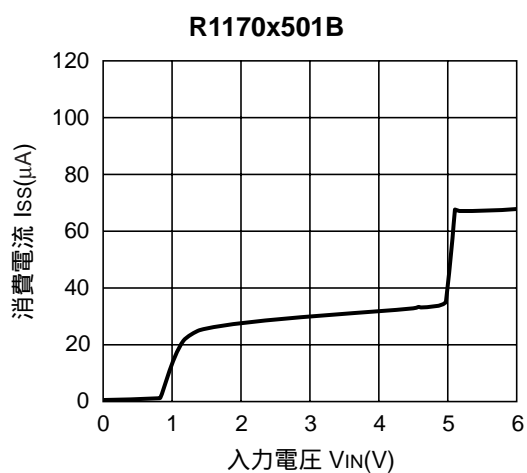
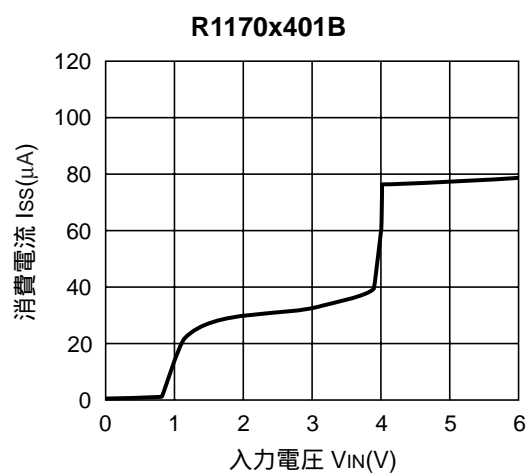
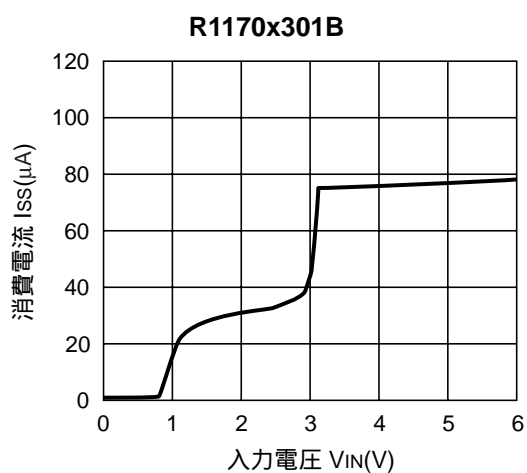
5) 消費電流対入力電圧特性例 ($T_{opt}=25^{\circ}C$)

R1170x151B

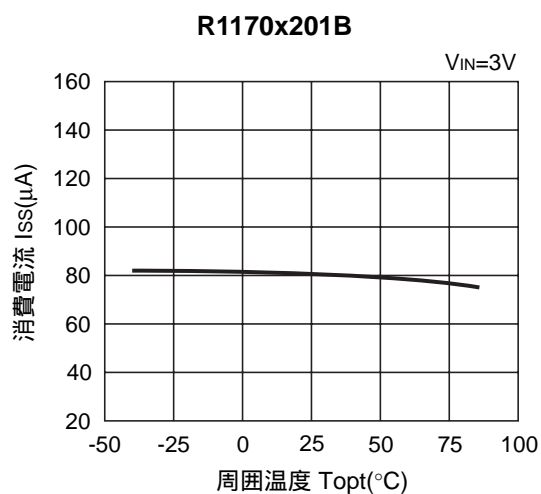
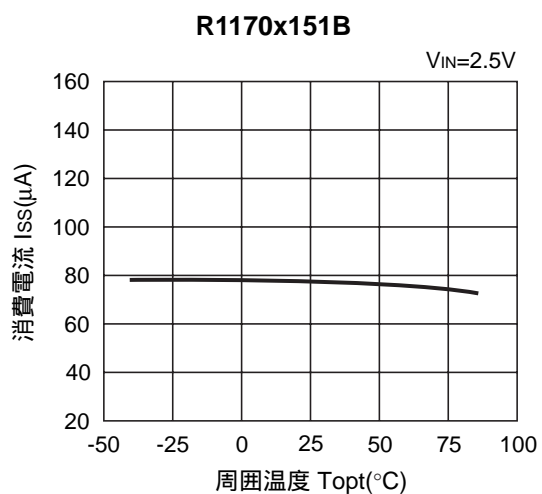


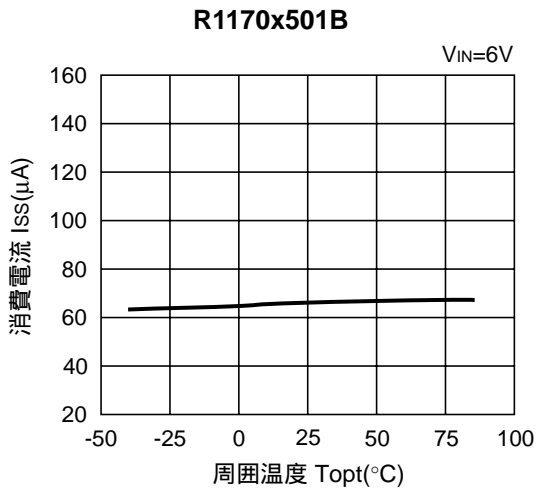
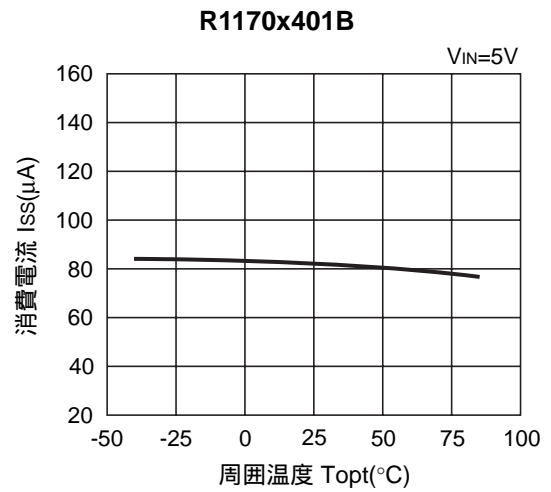
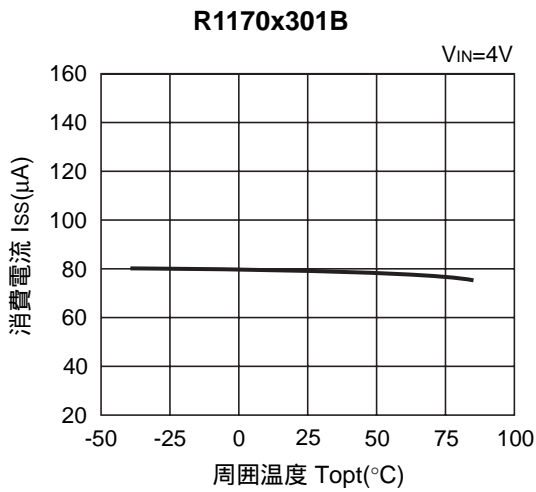
R1170x201B



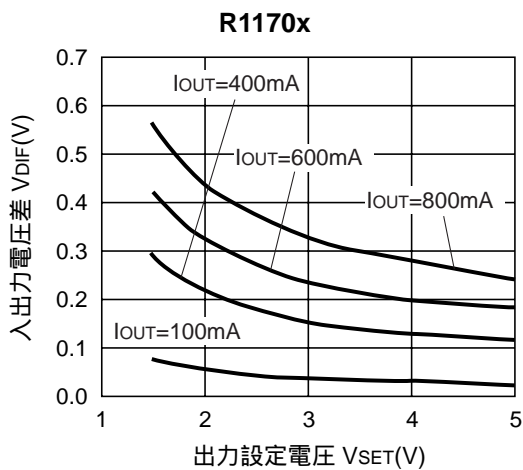


6) 消費電流対周囲温度特性例

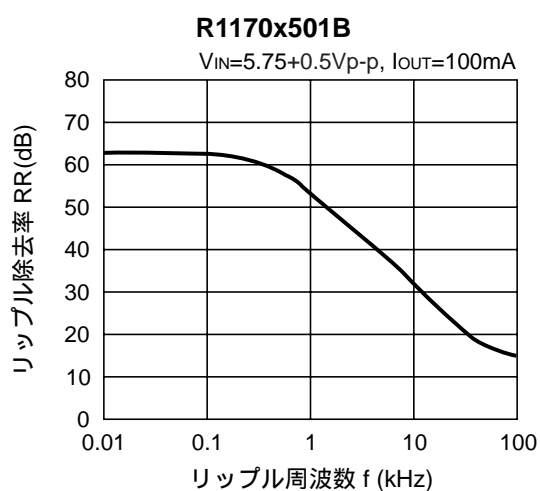
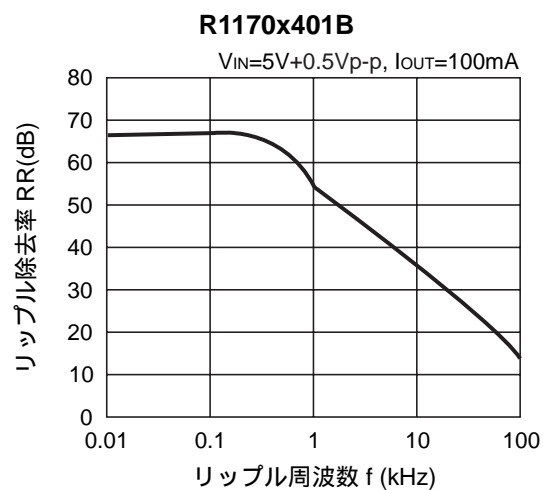
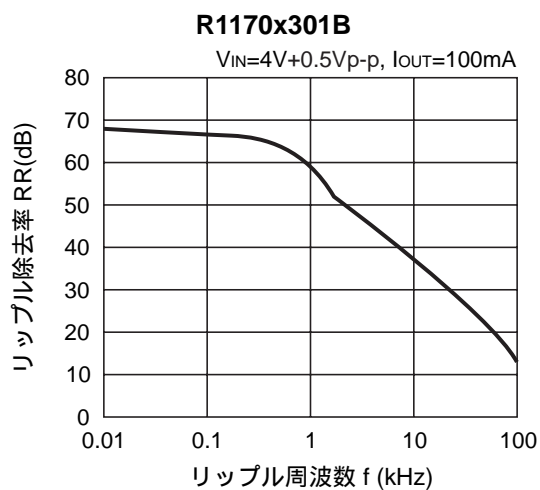
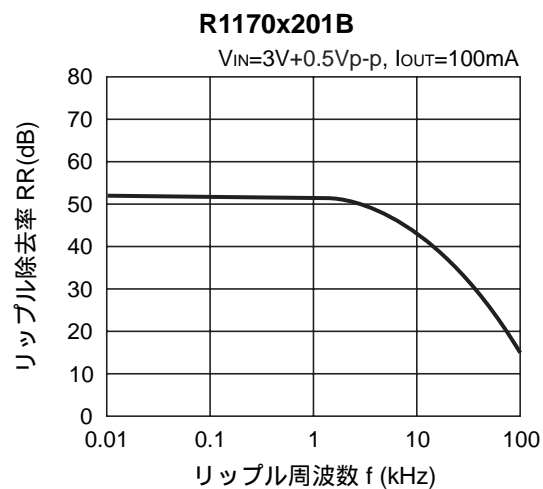
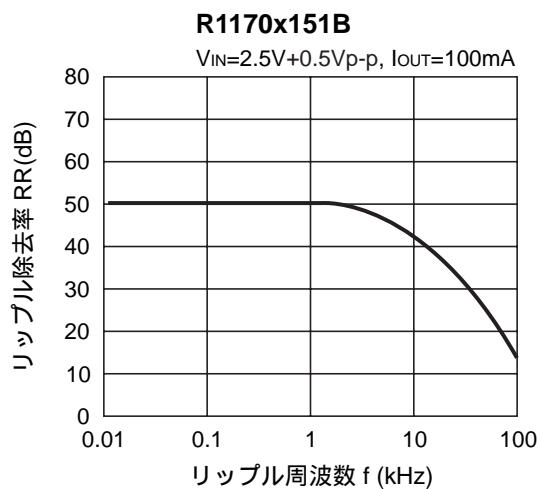




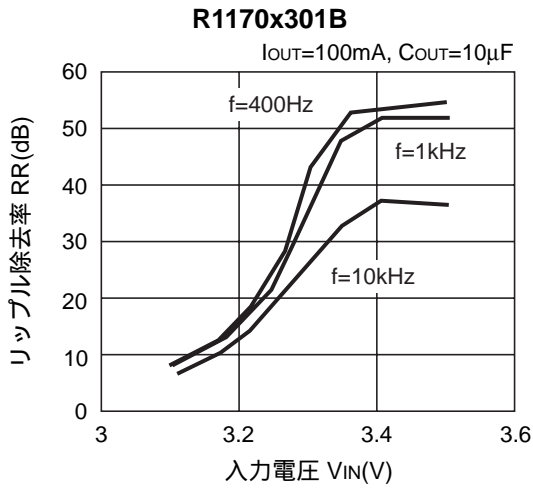
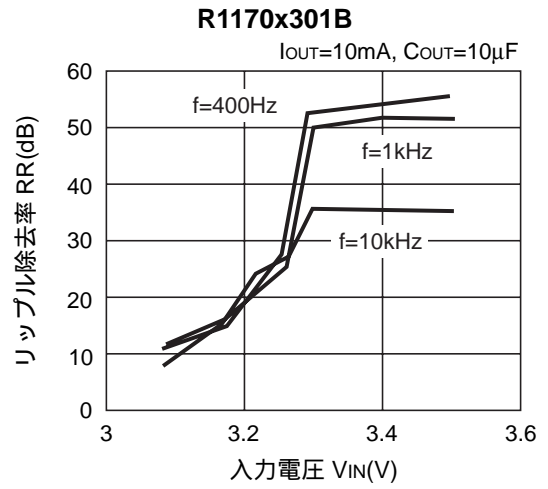
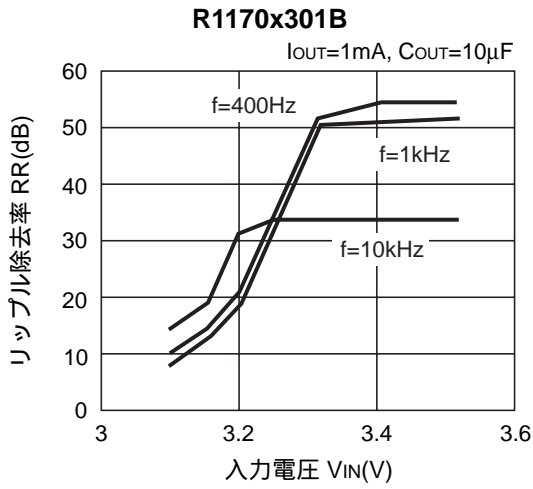
7) 入出力電圧差対出力電圧特性例 ($T_{opt}=25^{\circ}C$)



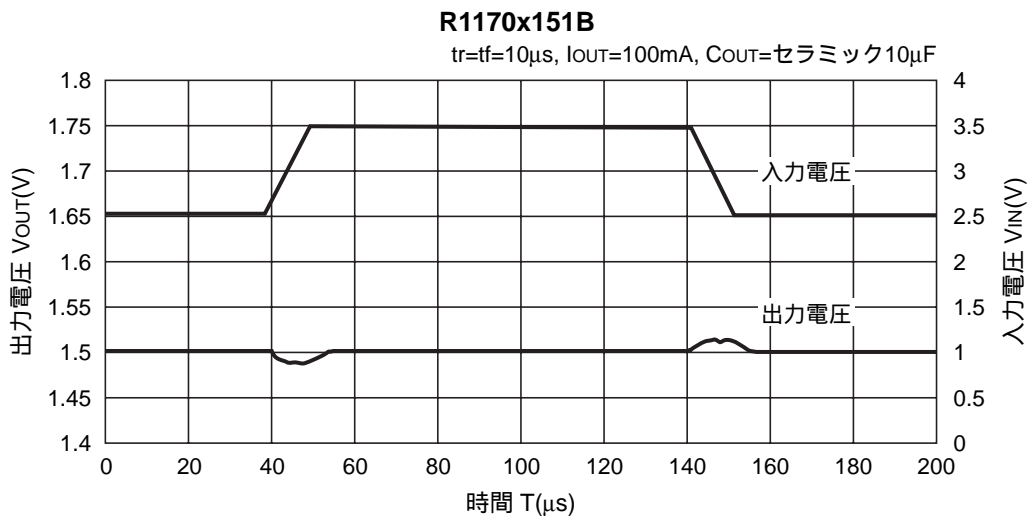
8) リップル除去率対周波数特性例

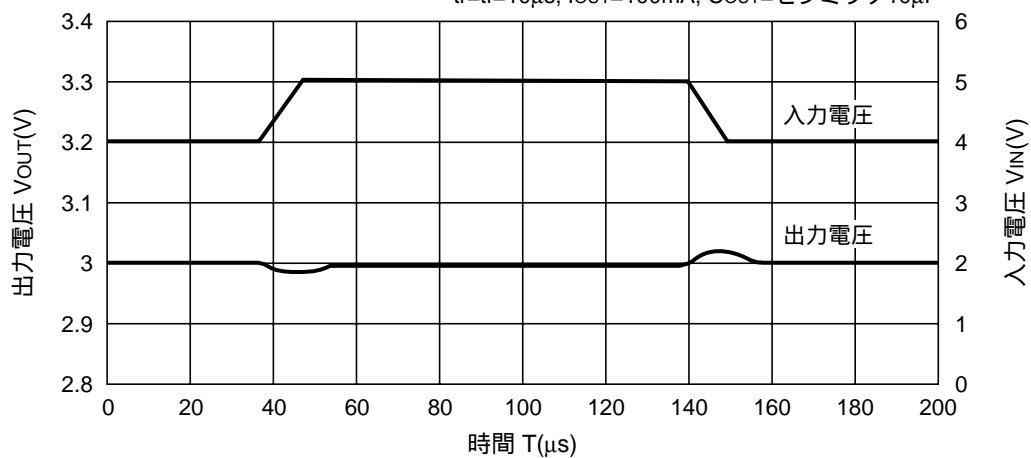
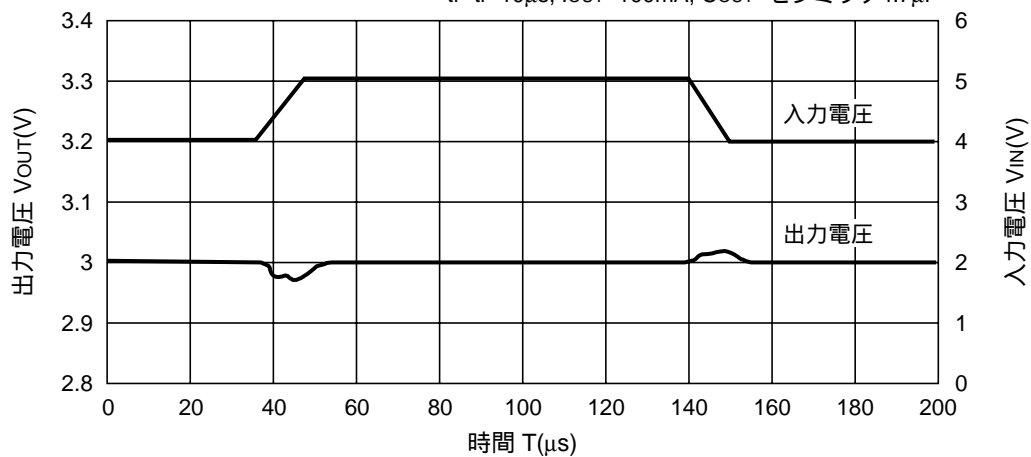
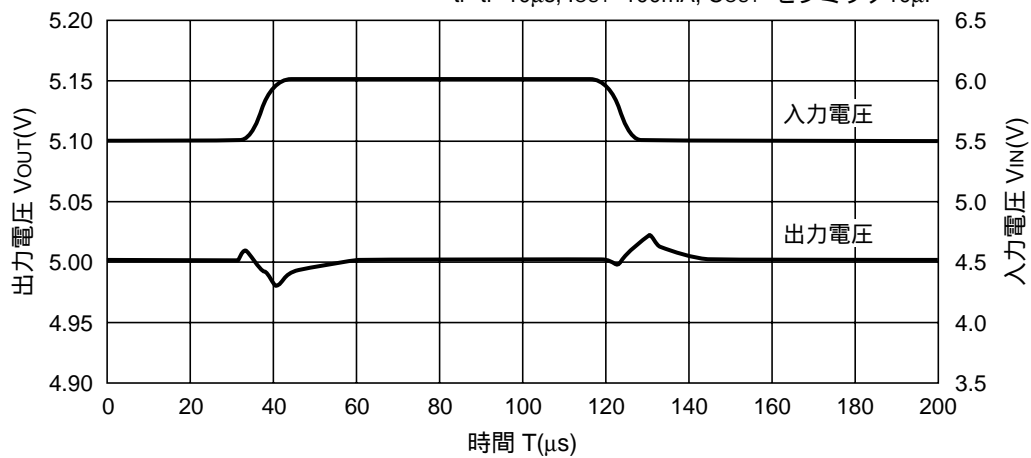


9) リップル除去率対入力電圧特性例



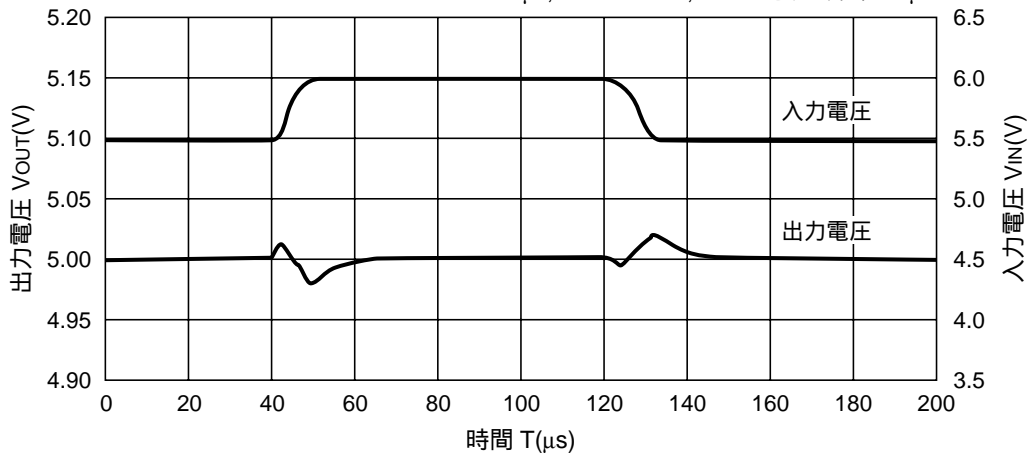
10) 入力過渡応答特性例 ($T_{opt}=25^{\circ}C$)



R1170x301Btr=tf=10 μ s, I_{OUT}=100mA, C_{OUT}=セラミック10 μ F**R1170x301B**tr=tf=10 μ s, I_{OUT}=100mA, C_{OUT}=セラミック4.7 μ F**R1170x501B**tr=tf=10 μ s, I_{OUT}=100mA, C_{OUT}=セラミック10 μ F

R1170x501B

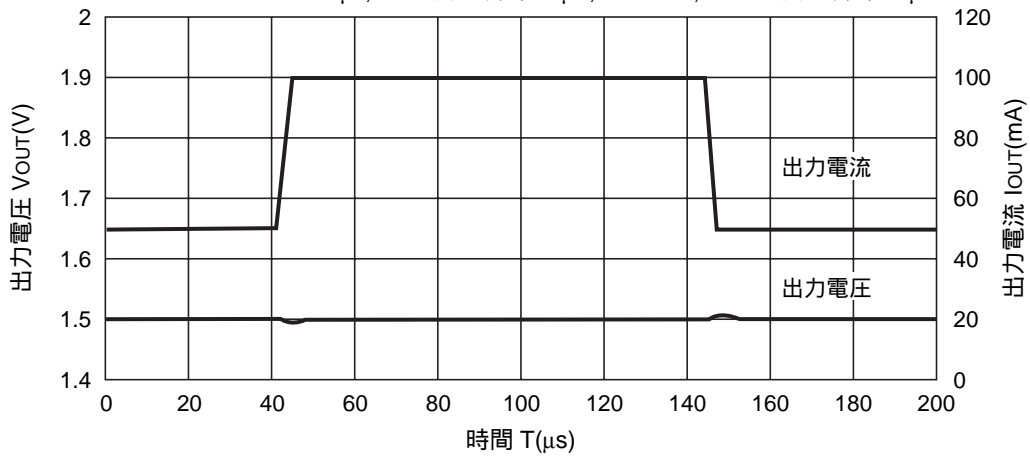
tr=tf=10μs, IOUT=100mA, COUT=セラミック4.7μF



11) 負荷過渡応答特性例 (Topt=25°C)

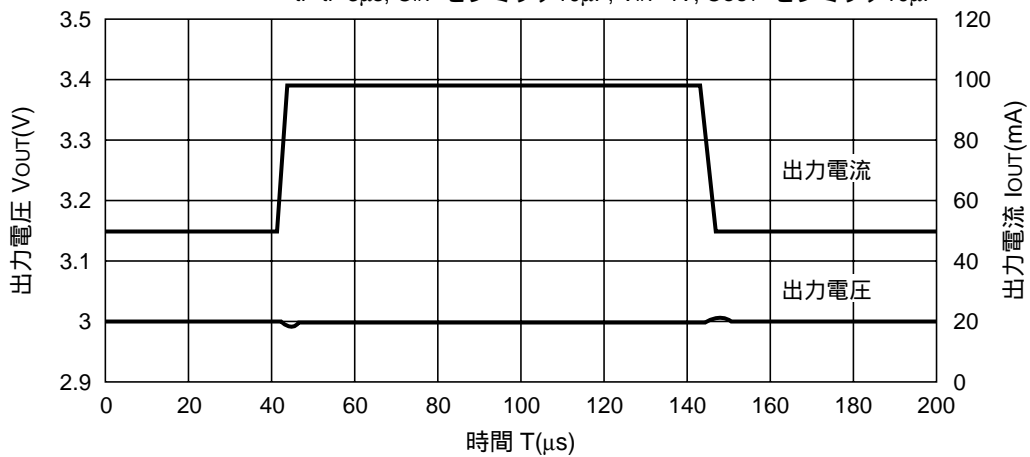
R1170x151B

tr=tf=3μs, CIN=セラミック10μF, VIN=2.5V, COUT=セラミック10μF

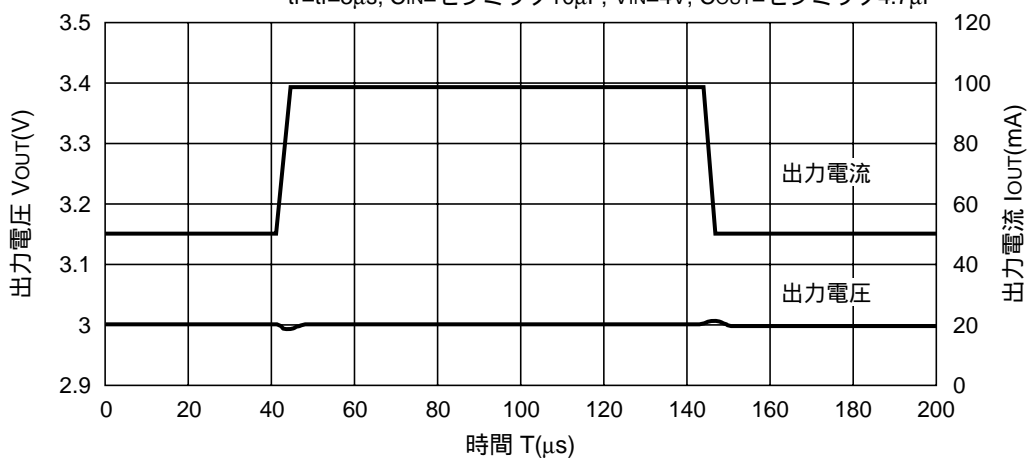


R1170x301B

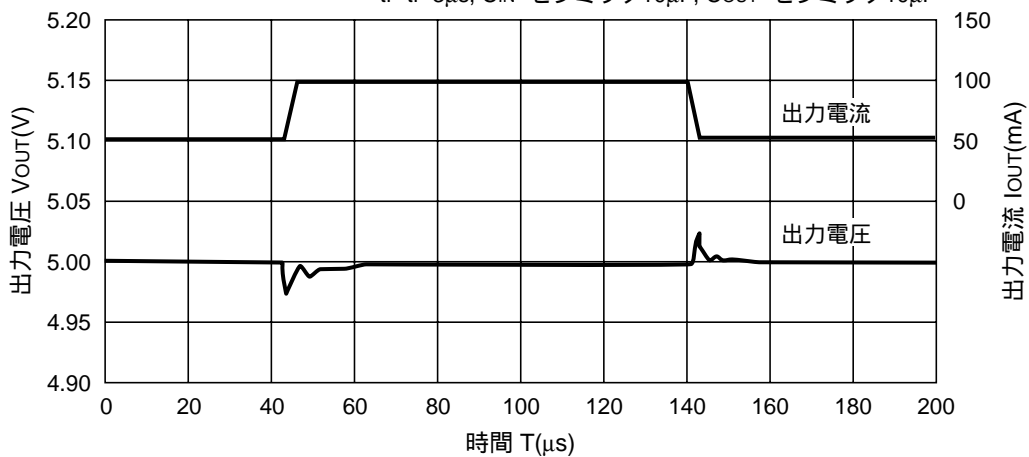
tr=tf=3μs, CIN=セラミック10μF, VIN=4V, COUT=セラミック10μF



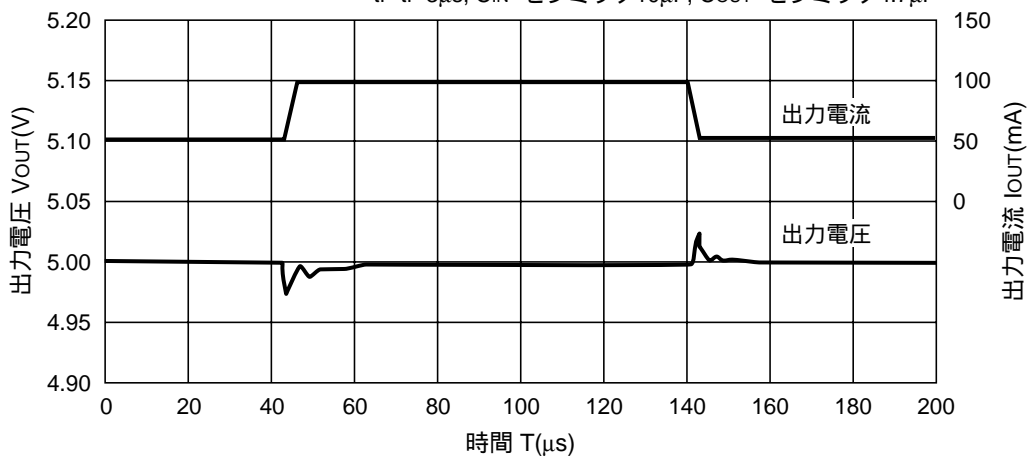
R1170x301B

tr=tf=3 μ s, C_{IN}=セラミック10 μ F, V_{IN}=4V, C_{OUT}=セラミック4.7 μ F

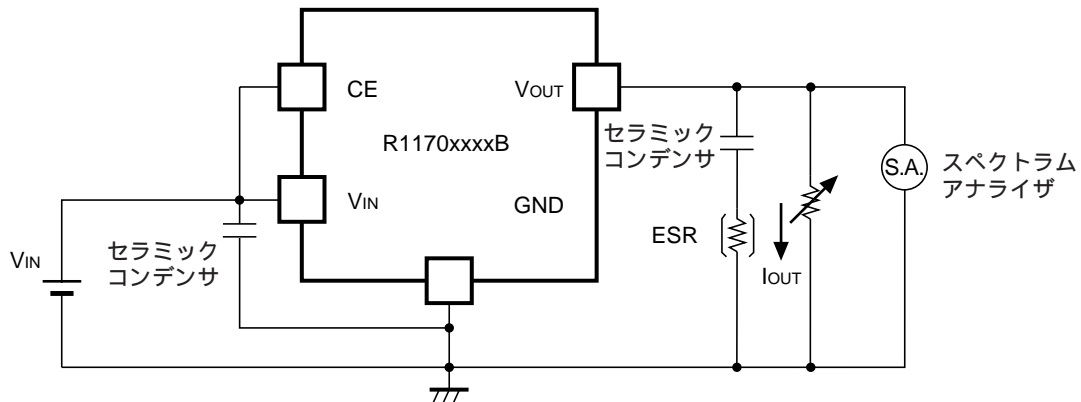
R1170x501B

tr=tf=3 μ s, C_{IN}=セラミック10 μ F, C_{OUT}=セラミック10 μ F

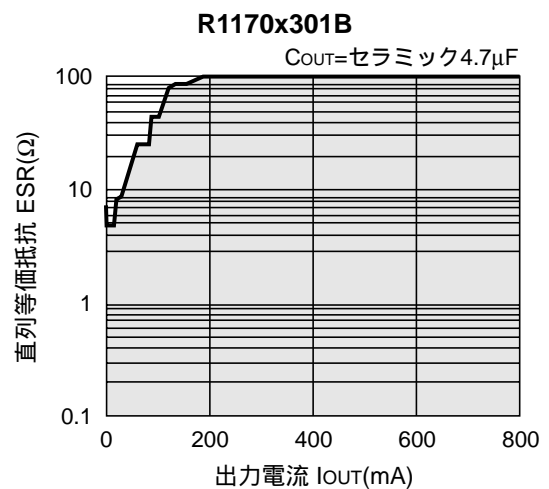
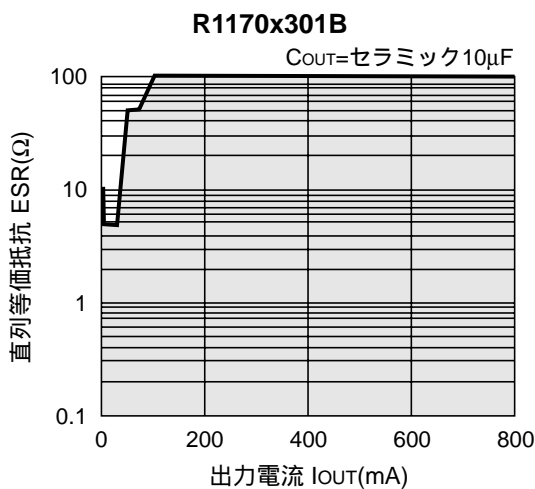
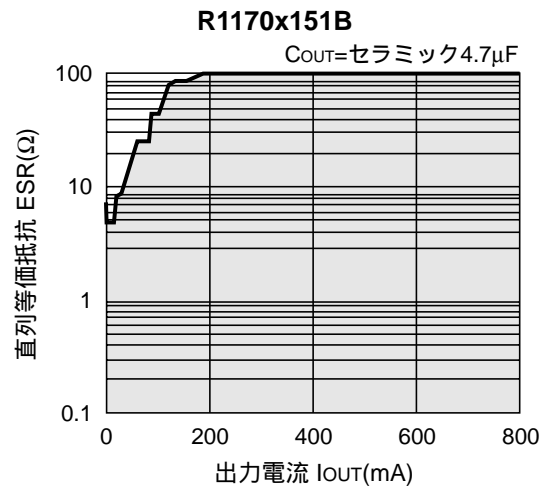
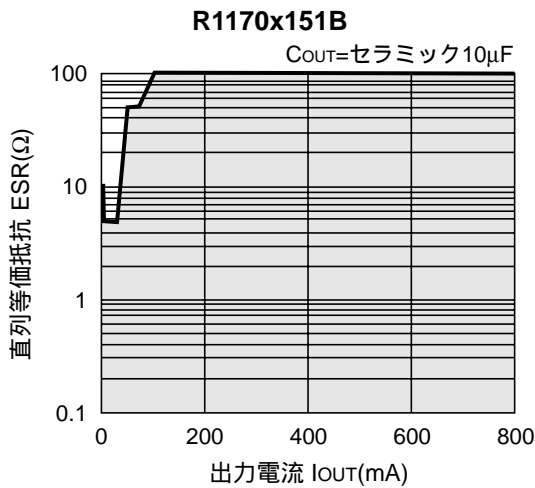
R1170x501B

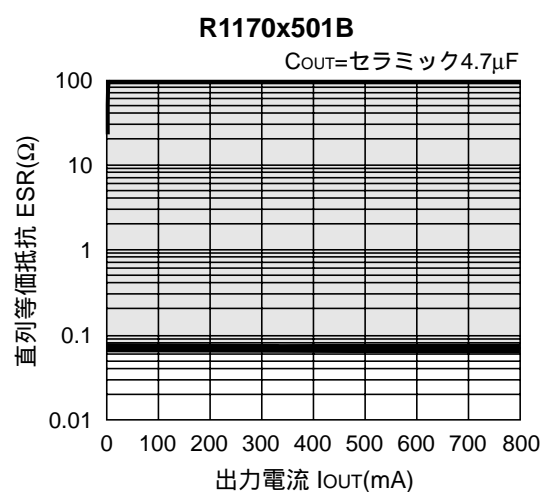
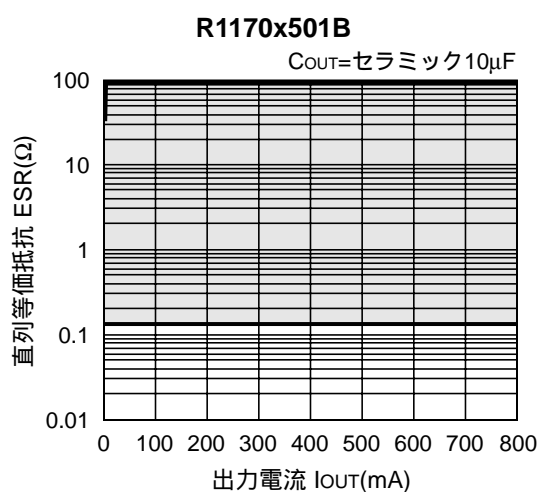
tr=tf=3 μ s, C_{IN}=セラミック10 μ F, C_{OUT}=セラミック4.7 μ F

12) ノイズ対策 (Topt=25°C, V_{IN}=出力設定電圧+1V, C_{IN}=セラミック 10μF)



本製品は、セラミックコンデンサ推奨ですが、他の低ESRタイプのコンデンサも使用可能です。
 参考資料として上記のような回路でノイズレベルを測定した際にそのレベルが40μV以下となるESRの上限値の境界を示したESR対出力電流のグラフを示します。(斜線部が安定領域)





その他注意事項

*出力コンデンサとして容量の大きな物をつかわれますと、出力の立ち上がり時間が、内部チャージの状況によって通常より早くなることがあります。



本ドキュメント掲載の技術情報及び半導体のご使用につきましては以下の点にご注意ください。

1. 本ドキュメントに記載しております製品及び製品仕様は、改良などのため、予告なく変更することがあります。又、製造を中止する場合がありますので、ご採用にあたりましては当社又は販売店に最新の情報をお問合せください。
2. 文書による当社の承諾なしで、本ドキュメントの一部、又は全部をいかなる形でも転載又は複製されることは、堅くお断り申し上げます。
3. 本ドキュメントに記載しております製品及び技術情報のうち、「外国為替及び外国貿易管理法」に該当するものを輸出される場合、又は国外に持ち出される場合は、同法に基づき日本国政府の輸出許可が必要です。
4. 本ドキュメントに記載しております製品及び技術情報は、製品を理解していただくためのものであり、その使用に関して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証、又は実施権の許諾を意味するものではありません。
5. 本ドキュメントに記載しております製品は、標準用途として一般的電子機器(事務機、通信機器、計測機器、家電製品、ゲーム機など)に使用されることを意図して設計されております。故障や誤動作が人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある特別な品質、信頼性が要求される装置(航空宇宙機器、原子力制御システム、交通機器、輸送機器、燃焼機器、各種安全装置、生命維持装置等)に使用される際には、必ず事前に当社にご相談ください。
6. 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。故障の結果として人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意ください。誤った使用又は不適切な使用に起因するいかなる損害等についても、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
7. 本ドキュメントに記載しております製品は、耐放射線設計はなされてございません。
8. X線照射により製品の機能・特性に影響を及ぼす場合があるため、評価段階で機能・特性を確認の上でご使用ください。
9. WLCSPパッケージの製品は、遮光状態でご使用ください。光照射環境下(動作、保管中含む)では、機能・特性に影響を及ぼす場合があるためご注意ください。
10. パッケージ捺印は、画像認識装置の仕様によって文字認識に差が生じることがあります。画像認識装置にて文字認識をする場合は、事前に弊社販売店または弊社営業担当者までお問い合わせください。
11. 本ドキュメント記載製品に関する詳細についてのお問合せ、その他お気付きの点がございましたら当社又は販売店までご照会ください。

NISSHINBO

日清紡マイクロデバイス株式会社

公式サイト

<https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/>

購入のご案内

<https://www.nisshinbo-microdevices.co.jp/ja/buy/>

●お問い合わせ・ご用命は...